



第4回

筑波大学パワーエレクトロニクス未来技術研究会

University of Tsukuba Forum on Power Electronics Tomorrow (UTOP)

「GaN パワーデバイス、実装技術とその応用」

日時： 2016年2月5日(金) 13時20分～17時40分

場所： 筑波大学東京キャンパス文京校舎1階134講義室

東京都文京区大塚3-29-1(地下鉄丸ノ内線茗荷谷駅より徒歩2分)

参加費：3,000円(資料代を含む、学生は無料)

意見交換会：林野会館にて

主催： 筑波大学数理物質系

共催： NPO 未来アジア技術フォーラム (TeFFA)

後援： パワーエレクトロニクス学会

協賛： Tsukuba Power Electronics Constellations (TPEC)

プログラム

座長：筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 助教 岡本 大

13:20 筑波大学パワーエレクトロニクス研究室の近況ご紹介

筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 教授 岩室 憲幸

13:30 「SiC 熱酸化 SiO₂ 膜の絶縁特性制御」

筑波大学 数理物質科学研究科 教授 山部 紀久夫 / 准教授 蓮沼 隆

14:20 「GaN パワーデバイスの活用と太陽光 PCS への応用」

(株)安川電機 環境エネルギー機器事業統括部 井手 耕三

15:10～15:25 休憩

座長：筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 准教授 矢野 裕司

15:25 「GaN HEMT パワーモジュール実装技術」

トランスフォーム・ジャパン(株) 庄野 健 / 吉川 俊英 / 細田 勉

16:15 「GaN パワーデバイス (GIT) 技術」

パナソニックセミコンダクターソリューションズ(株) 半導体 BU

技術開発センター 上本 康裕

司会：筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 教授 只野 博

17:10 パネルディスカッション「より使いやすい GaN パワーデバイスを目指して」

17:40 閉会

18:00～19:30 意見交換会(会費3,000円、林野会館にて)

参加申し込み先：teffareg@ybb.ne.jp (1/29(金) 締切り)

(氏名、所属、e-mailアドレス、意見交換会への参加/不参加をご連絡ください。)